

# 2SK2633LS

NチャンネルMOS形シリコン電界効果トランジスタ  
超高速スイッチング用

暫定規格

- 特長
- ・低オン抵抗。
  - ・低 $Q_g$ 化。

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings /  $T_a = 25^\circ\text{C}$

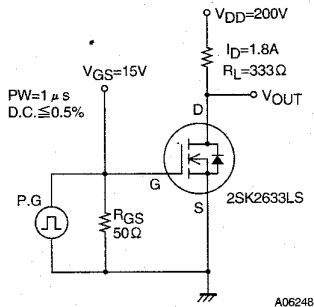
			unit
ドレイン・ソース電圧	$V_{DSS}$	800	V
ゲート・ソース電圧	$V_{GSS}$	$\pm 30$	V
ドレイン電流 (DC)	$I_D$	3	A
ドレイン電流 (パルス)	$I_{DP}$	9	A
許容損失	$P_D$	30	W
チャンネル温度	$T_{ch}$	150	$^\circ\text{C}$
保存周囲温度	$T_{stg}$	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

$T_c = 25^\circ\text{C}$

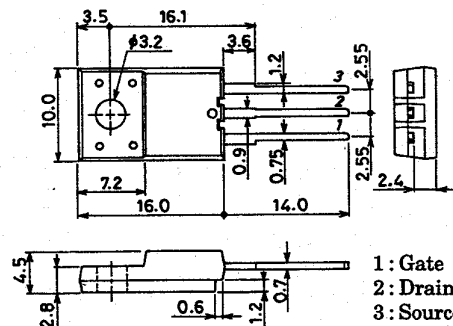
電気的特性 Electrical Characteristics /  $T_a = 25^\circ\text{C}$

			min	typ	max	unit
ゲート・ソース降伏電圧	$V_{(BR)DSS}$	$I_D = 1\text{mA}, V_{GS} = 0$	800			V
ドレイン・ソースしゃ断電流	$I_{DSS}$	$V_{DS} = 800\text{V}, V_{GS} = 0$			1.0	mA
ゲート・ソースもれ電流	$I_{GSS}$	$V_{GS} = \pm 30\text{V}, V_{DS} = 0$			$\pm 100$	nA
カットオフ電圧	$V_{GS(off)}$	$V_{DS} = 10\text{V}, I_D = 1\text{mA}$	3.5		5.5	V
順伝達アドミタンス	$ Y_{fs} $	$V_{DS} = 10\text{V}, I_D = 1.8\text{A}$	0.9	1.8		S
飽和抵抗	$R_{DS(on)}$	$I_D = 1.8\text{A}, V_{GS} = 15\text{V}$		2.8	3.6	$\Omega$
入力容量	$C_{iss}$	$V_{DS} = 20\text{V}, f = 1\text{MHz}$		700		pF
出力容量	$C_{oss}$	$V_{DS} = 20\text{V}, f = 1\text{MHz}$		180		pF
帰還容量	$C_{rss}$	$V_{DS} = 20\text{V}, f = 1\text{MHz}$		100		pF
ゲート入力電荷量	$Q_g$	$V_{DS} = 200\text{V}, I_D = 3\text{A}$ $V_{GS} = 10\text{V}$		20		nC
ターンオン遅延時間	$t_{d(on)}$	下図指定回路において		20		ns
立上り時間	$t_r$	"		20		ns
ターンオフ遅延時間	$t_{d(off)}$	"		50		ns
下降時間	$t_f$	"		25		ns
ダイオード順電圧	$V_{SD}$	$I_S = 3\text{A}, V_{GS} = 0$			1.2	V

スイッチングタイム測定回路図



外形図 2078B  
(unit: mm)



- 1: Gate
- 2: Drain
- 3: Source

SANYO: TO-220FI(LS)

本製品は開発中です。  
詳細については営業担当者にご連絡ください。